

1N4148(玻封)

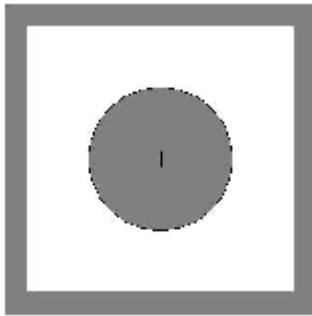
■用途:

* 用于高压、高速开关应用。

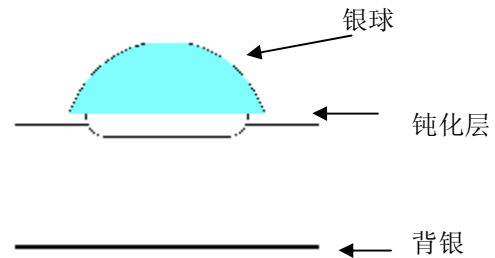
■特征

- *较低的正向压降
- *较小的总电容
- *较短的反向恢复时间
- *用于 DO35 封装

■管芯示意图:



■外形示意图:



■芯片结构:

芯片尺寸	250 μ m \times 250 μ m
芯片厚度(含银点)	155 \pm 10 μ m
金属层	正面: 银点 (40 \pm 10 μ m) 背面: 银 (1.9 \pm 0.2 μ m)

■参数规范及参数测试值:

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
正向压降	V_F (1)	$I_F=10\text{mA}$		1.0	V
	V_F (2)	$I_F=100\text{mA}$		1.2	V
反向电压	V_R	$I_R=0.1\text{mA}$	100		V
反向漏电流	I_R (1)	$V_R=20\text{V}$		25	nA
	I_R (2)	$V_R=75\text{V}$		100	nA
总电容	C_T	$V_R=0, f=1\text{MHz}$		3.0	PF
反向恢复时间	t_{rr}	$I_F=I_R=10\text{mA},$ $I_{rr}=0.1\times I_R$		4.0	ns